

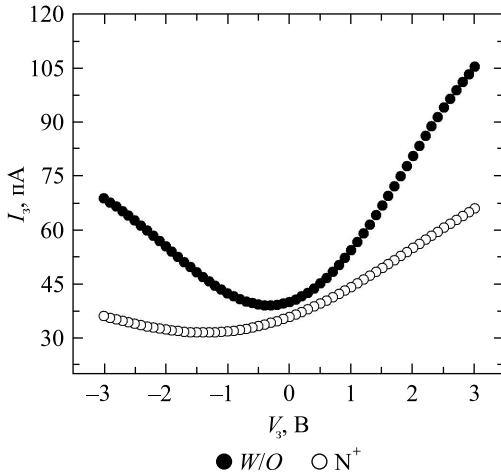


Рис. 2. Зависимость тока утечки затвора (I_3) от напряжения на затворе (V_3) для образцов, имплантированных ионами азота (N^+) дозой $2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-2}$ с энергией 40 кэВ (прямой процесс отжига), и соответствующих контрольных образцов (W/O)

Fig. 2. Dependence of the gate leakage current (I_3) on the gate voltage (V_3) for samples implanted by nitrogen ions (N^+) with a dose of $2 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ by energy of 40 keV (forward annealing order), and corresponding control samples (W/O)